DIALOG(R) File 347: JAPIO (c) 1999 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

# Best Available Copy

05173859 \*\*Image available\*\*
ELECTROLUMINESCENCE DISPLAY DEVICE

PUB. NO.: **08-129359** [JP 8129359 A]

PUBLISHED: May 21, 1996 (19960521)

INVENTOR(s): TAKAYAMA ICHIRO

ARAI MICHIO

APPLICANT(s): TDK CORP [000306] (A Japanese Company or Corporation), JP

(Japan)

SEMICONDUCTOR ENERGY LAB CO LTD [470730] (A Japanese Company

or Corporation), JP (Japan)

APPL. NO.: 06-267243 [JP 94267243]

FILED:

October 31, 1994 (19941031)

#### **ABSTRACT**

PURPOSE: To make it hardly influenced by the noise of a selection switch, etc., by selecting the combination of ON/OFF of plural drive TFTs in one pixel and performing gradation display by controlling a current flowing through an EL element.

CONSTITUTION: When transisters M4-M6 are selected by means of a selection signal ym from a Y-axis shift register, an X-axis register outputs a shift signal in the order of selection signals Xn1-Xn3. The driving voltage of an image data signal -VL having digital H or L is held synchronized with the shifts of the selection signals Xn1-Xn3, drive TFTs M1-M3 having L are turned on and an EL power source 1 is supplied to an EL element Elnm through the drive TFT. When all drive TFTs M1-M3 are turned on, the EL element ELnm emits light with the maximum luminance and the gradation display is performed by selecting the drive TFTs M1-M3.

(19)日本国特許庁(JP)

## (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出廣公開番号

特開平8-129359

(43)公開日 平成8年(1996)5月21日

(51) IntCL\*

 FI

技術表示适所

G 0 9 G 3/30

J 4237-5H

H 0 5 B 33/08

### 審査請求 未請求 請求項の数3 OL (全 9 頁)

(21) 出題番号

特圈平6-267243

(71)出職人 000003067

ティーディーケイ・株式会社

東京都中央区日本橋1丁目13番1号

(22)出顯日

平成6年(1994)10月31日

(71) 出題人 000153878

株式会社半導体エネルギー研究所

神奈川県厚木市長谷398番地

(72) 発明者 高山 一郎

神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社半

事体エネルギー研究所内

(72) 発明者 荒井 三千男

東京都中央区日本橋一丁目13番1号 ティ

ーディーケイ株式会社内

(74)代理人 弁理士 平岡 憲一 (外2名)

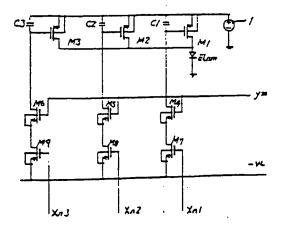
## (54) [発明の名称] エレクトロルミネセンス表示装置

#### (57) 【要約】

【目的】 1 画素中の複数のドライブ薄膜トランジスタを画像データ信号-VLでオン、オフさせ、選択スイッチ等のノイズの影響を受けにくくすることを目的とする。

【構成】 1画素中にエレクトコルミネセンス素子ELnmを駆動する複数のドライブ薄膜トランジスタM1~M3とを設け、この複数のドライブ薄膜トランジスタM1~M3を選択することにより階調表示を行う。

## 本発明の第1実施例の説明図



20

50

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 1 画素毎にエレクトコルミネセンス素子 と、

数エレクトロルミネセンス素子を駆動する複数のドライ ブ薄膜トランジスタとを設け、

前記複数のドライブ薄膜トランジスタを選択することに より階調表示を行うことを特徴としたエレクトコルミネ センス表示装置。

【請求項2】 前記複数のドライブ薄膜トランジスタ れていることを特徴とした請求項1記載のエレクトコル ミネセンス表示装置。

【請求項3】 前記複数のドライブ薄膜トランジスタの 駆動電圧の保持にラッチ回路を設けることを特徴とした 請求項1又は2記載のエレクトロルミネセンス表示装 置。

## 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【産業上の利用分野】本発明は、薄膜トランジスタ(以 下、TFTという)を用いてエレクトロルミネセンス (以下、ELという)素子を駆動するEL表示装置に関 する。

#### [0002]

【従来の技術】図4~図6は従来例を示した図である。 以下、図面に基づいて従来例を説明する。

【0003】図4(a)は、パネルブロック図であり、 ディスプレイ(表示)パネル10には、ディスプレイ画 面11、X軸のシフトレジスタ12、Y軸のシフトレジ スタ13が設けてある。

【0004】ディスプレイ画面11には、EL電源が供 30 給されており、またX軸のシフトレジスタ12には、シ フトレジスタ電源の供給とX軸同期信号の入力が行われ る。さらにY軸のシフトレジスタ13には、シフトレジ スタ電源の供給とY軸同期信号の入力が行われる。ま た、X軸のシフトレジスタ12の出力部に画像データ信 号の出力が設けてある。

【0005】図4(b)は、図4(a)のA部の拡大説 明図であり、ディスプレイ画面11の1画素(点線の四 角で示す) に対して、トランジスタが2個、コンデンサ が1個、EL素子が1個より構成されている。

【0006】この1画素の発光動作は、例えば、Y軸の シフトレジスタ13で選択信号y1の出力があり、また X軸のシフトレジスタ12で選択信号x1の出力があっ た場合、トランジスタTy11とドランジスタTx1が オンとなる。

【0007】このため、画像データ信号-VLは、ドラ イブトランジスタM11のゲートに入力される。これに より、このゲート電圧に応じた電流がEL電源からドラ イプトランジスタM11のドレイン、ソース間に流れ、 Eも素子Eもするが発光する。

【0008】次のタイミングでは、X軸のシフトレジス タ12は、選択信号x1の出力をオフとし、選択信号x 2を出力することになるが、ドライブトランジスタM1 1のゲート電圧は、コンデンサで11で保持されるた め、次にこの画素が選択されるまでEL素子EL11の 前記発光は、持続することになる。

【0009】図5は、従来例のY軸シフトレジスタの説 明図である。図5において、ナンド回路21と22は波 形整形回路であり、逆位相のクコックーCLと低レベル は、それぞれ相互コンダクタンスが異なるもので構成さ 10 ( L. )のスタートパルスーSPが入力される。まり た、クコックドインバータ26~32とインバータ33 ~37はシフトレジスタである。さらに、インバータ3 8~43とナンド回路23~25は、選択信号x1~x 3を出力する論理回路である。

> 【0010】クコックCLと逆位相グニックーCLは、 一方が高レベル(『H』)の時他方が低レベル (『L』) になる。クロックドインバータは、クロック CL入力が「L」で逆位相クコックーCL入力が「H」 のときアクティブ状態となり、インバータとして動作 し、また逆に、クコックCL入力が「H」で逆位相クコ ックーCL入力が「L」のときハイインピーダンス状態 となるものである。

【0011】例えば、クコックドインバータ26とクコ ックドインバータ29とは、クコックCL入力と逆位相 クコック入力-CLとが逆に接続されている。このた め、クロックドインバータ26がアクティブ状態の時、 クロックドインバータ29はハイインピーダンス状態と なる。

【0012】図6は、従来例の波形説明図であり、以 下、図3のX軸のシフトレジスタの動作を図6の各点の 波形に基づいて説明する。

(1) 波形整形回路の出力であるA点の電位は、スター トパルスーSP(『L』)がない時「H』である。この 時、「L」のスタートパルス-SPが入力されると、A 点は「L」となる(図6、A参照)。

【0013】(2) B点は、A点が「L」になる時、ク コックドインバータ26はアクティブ状態となるので、 「H」となり、次にクロックドインバータ26がハイイ ンピーダンス状態となる時、クロックドインバータ29 がアクティブ状態となるので、前記B点の「H」がクコ ックドインバータ29のアクティブ期間だけ保持される (図6、B参照)。

【0014】(3) C点は、インバータ33によりB点 と逆位相の波形となる(図6、C参照)。

(4) D点は、クコックドインバータ29と同時にアク ティブ状態となるクロックドインバータ27と、インバ ータ34とクロックドインバータ30による保持回路に よりB点より半クコックサイクル遅れた波形となる。

【0015】(5) E点は、インバータ34によりD点 と逆位相の波形となり、C点の波形より半クロックサイ

クル遅れた波形となる(図6、E参照)。

(6) F点は、クコックドインバータ30と同時にアクティブ状態となるクコックドインバータ28と、インバータ35とクコックドインバータ31による保持回路により口点より半クコックサイクル遅れた波形となる。 【0016】(7) G点は、インバータ35によりF点と逆位相の波形となり、E点の波形より半クコックサイクル遅れた波形となる(図6、G参照)。

(8) H点は、インバータ38によりC点の反転信号となる(図6、H参照)。 I点は、インバータ39により E点の反転信号となる(図6、I参照)。 また、J点は、インバータ40によりG点の反転信号となる(図 6、J参照)。

【0017】(9) K点は、ナンド回路23の出力であり、ナンド回路23の2つの入力にはH点とE点の信号が入力される。L点は、ナンド回路24の出力であり、ナンド回路24の2つの入力にはI点とG点の信号が入力される。また、M点は、ナンド回路25の出力であり、ナンド回路25の2つの入力にはJ点とインバータ(図示せず)からの信号が入力される。

【0018】(10)選択信号×1は、インバータ41によりK点の反転信号となり(図6、×1参照)、この選択信号×1は、Nチャネルの電界効果トランジスタT×1のゲートに入力される。このため、選択信号×1が「H」となるとトランジスタT×1がオンとなり、そのドレイン、ソース間が導通する。

【0019】 (11) 選択信号x 2は、インバータ42 によりL点の反転信号となり(図6、x 2参照)、この 選択信号x 2は、Nチャネルの電界効果トランジスタT x 2のゲートに入力される。このため、選択信号x 2が x 30 「x 1」となるとトランジスタT x 2がオンとなる。

【0020】(12)選択信号x3は、インバータ43によりM点の反転信号となり(図6、x3参照)、この選択信号x3は、Nチャネルの電界効果トランジスタT x3のゲートに入力される。このため、選択信号x3が「H: となるとトランジスタT x3がオンとなる。

【0021】このようにして、選択信号x1、x2、x3、・・・と順に、+/2 こックサイクルシフトとした信号が得られる。

#### [0022]

【発明が解決しようとする課題】上記のような従来のものにおいては、次のような課題があった。ドライブTFTM11、M21、M12、M22の駆動電圧(画像データ信号ーVL)は、アサニグ信号で伝達され、容量(ニンデンサC11、C21、C12、C22)に蓄積されるため、選択スイッチであるトランジスタTx1、Tx2、Ty11、Ty21、Ty12、Ty22等のノイズの影響を受け、高解像度、高階調を目指したとき限界があった。

【0023】また、ドライブTFTの駆動電圧は、その 50 8階調の表示を行うことができる。

トランジスタの近傍に設けられた容量に蓄積するため、 選択スイッチのオフ電流及びドライブTFTのゲート、 リーク電流によって時間と共にその信号が失われ、高解 像度、高階調を目指したとき、限界があった。

【0024】本発明は、1画素中に複数のドライブTFTを設け、デジタル信号でこれをオン、オフミせ、そのオン、オフドライブTFTの組み合わせにより、EL素子の階調表示を行い、選択スイッチ等のノイズの影響を受けにくくすること、また、ラッチ回路により、オフ電流、ゲート、リーク電流等の影響を受けないようにすることを目的とする。

#### [0025]

【課題を解決するための手段】本発明は、上記の課題を解決するため次のように構成した。図1は本発明の第1 実施例の説明図であり、1 画素中のEL素子ELnmの駆動回路を示す。図1は、EL電源1と、EL電源1に接続された複数のドライブ薄膜トランジスタ(TFT) M1、M2、M3と、これらのドライブTFTM1~M3によ駆動されるEL素子ELnmと、ドライブTFT 20 M1~M3のゲートに「H1又は「L1の画像データ信号-VLを与える選択スイッチであるトランジスタM4~M6を選択する選択信号ソーとトランジスタM7~M9を選択する選択信号ソーとトランジスタM7~M9を選択する選択信号ソーとトランジスタM7~M9を選択する選択信号ソーとによります。これでは、上記の課題を表現により、1~Xn3と、ドライブTFTM1~M3を駆動するゲート電圧を蓄積するコンデンサC1~C3を備える。

【0026】また、ドライブTFTM1、M2、M3の相互コンダクタンス(gm)をそれぞれ異なるもので構成する。さらに、図3の第2実施例の説明図のように、ドライブTFTの駆動電圧の保持に、クロックドインバータとインバータのラッチ回路を設ける。

#### [0027]

【作用】上記構成に基づく本発明の作用を説明する。図1において、Y軸のシフトレジスタからの選択信号ymによりトランジスタM4~M6が選択された時、X軸のシフトレジスタは選択信号Xn1からXn2、Xn3の順にシフト(走査)信号を出力する。そして、この選択信号Xn1~Xn3のシフトに同期して、デジタルの「H. 又は「L. の画像データ信号-VLを供給する。【0028】これにより、コンデンサC1~C3には「H. 又は「L. の画像データ信号-VLの駆動電圧が保持され、「L. となったドライブTFTがオンとなり、そのドライブTFTを通してEL電源1がEL素子ELnmに供給される。ドライブTFTM1~M3のすべてがオンの時、EL素子ELnmが最大輝度で発光する。

【0029】また、ドライブTFTM1、M2、M3の相互コンダクタンスの比を例えば2°、2°、2°にすることにより、ドライブTFTM1~M3の選択により8階調の表示を行うことができる。

【0030】さらに、図3において、ドライブTFTM 1~M3の駆動電圧の保持にラッチ回路を設けることに より、選択スイッチのオフ電流、ドライブTFTMI~ M3のゲート、リーク電流の影響を受けなくすることが できる。

【0031】このように、複数のドライブTFTM1~ M3のオン、オフの組み合わせにより階調表示を行い、 また、このドライブTFTの駆動電圧はオン、オフのデ ジタル信号なので、選択スイッチ等のノイズの影響を受 けることが少なくなる。

#### [0032]

#### 【実施例】

〔第1実施例の説明〕図1、図2は第1実施例の説明図 である。図1は、図4の従来例の1画素に相当する、E L素子ELnmの駆動回路を示す。図1において、EL 電源1に接続された3個のPチャネルのドライブTFT M1、M2、M3と、これらのドライブTFTM1~M 3により駆動される有機EL素子ELnmが設けてあ る。

[0033] また、これらのドライブTFTM1~M3 20 のゲートには、選択信号ym、XnI~Xn3により選 択スイッチであるNチャネルの電界効果トランジスタ (TFT) M4~M5、M7~M8を選択して「H. 又 は「L」のデジタル画像データ信号-VLが供給され る。そして、この画像データ信号-VLは、コンデンサ C1、C2、C3により保持される。

【0034】さらに、これらのドライブTFTMI、M 2、M3の相互コンダクタンスの比は、それぞれ2: 、 2:、21 となるように、ゲート (チャネル) の長さ又 は幅を変化させてある。これにより、ドライブTFTM 30 1のオン電流を1とすると、ドライブTFTM2のオン 電流は2、ドライブTFTM3のオン電流は4となる。 【0035】図2は、第1実施例における波形説明図で ある。以下、図2に基づいて、図1の回路の動作を説明 する。X軸のシフトレジスタによりクロックCLの3倍 の選択信号(シフトパルス)Xn1、Xn2、Xn3・ ・・を発生させる(図2、Xn1、Xn2、Xn3参 照)。また、画像データ信号-VLは、シフトパルスX n1、Xn2、Xn3・・・に同期した「H」又は 「L」のデジタル信号が出力される(図2、-VL参 照)。なお、図2のx1、X2は従来例のX軸シフトレ ジスタの選択信号を示す。

【0036】 (1) 今、Y軸のシフトレジスタの選択信 号ymが『H』の時、まず、選択信号Xn1が『H』に なると、トランジスタM4とトランジスタM7がオンと なる。このため、この時の画像データ信号ーVLの 「L」がドライブTFTM1のゲートに与えられ、この ドライブTFTM1がオンとなる。この「L」のゲート 電圧は、コンデンサC1により保持される。

ると、トランジスタM5とトランジスタM8がオンとた る。このため、この時の画像データ信号-VLの「L がドライブTFTM2のゲー トに与えられ、ドライブT FTM2はオフとなる。この「H」のゲート電圧はコン デンサC2により保持される。

【0038】(3)次に、選択信号Xn3が「H」にな ると、トランジスタM6とトランジスタM9がオンとな る。このため、この時の画像データ信号-VLの「L がドライブTFTM3のゲートに与えられ、ドライブT 10 FTM3はオンとなる。この「L」のゲート電圧は、コ ンデンサC3により保持される。

【0039】この図2の例の画像データ信号-VLの場 合、ドライブTFTM1とM3がオンとなりドライブT FTM2がオフとなる。これにより、EL素子ELnm には、EL電源1より、ドライブTFTM-1の電流を1 とした時の5倍の電流が流れることになる。

【0040】このように、1画素中にgmの異なる3個 のドライブTFTを設けこれをオン、オフさせる組み合 わせによって、EL素子に流れる電流を制御し、8階調 表示を行うことができる。

【0041】 〔第2実施例の説明〕 図3は、第2実施例 の説明図である。図3は、1画素に相当するEL素子E Lnmの駆動回路を示す。図3の例は、ドライブでTF TM1~M3の駆動電圧を保持するのに図1のコンデン サC1~C3のかわりにクロックドインバータ2~4と インバータる~7のラッチ回路を設けたものである。こ の場合、インバータ5~7を設けたため、図1とは反転 したデジタルの画像データ信号VLを供給することにな

【0042】また、クロックドインバータ2~4の参照 (レファレンス) 電圧refn1~refn3として、 それぞれ選択信号Xn1~Xn3の反転信号が与えられ る。このため、トランジスタM7~M9がオンのとき、 それぞれ対応するクロックドインバータ2~4がハイイ ンピーダンス状態となり、トランジスタM7~M9がオ フのとき、それぞれ対応するクコックドインパータ2~ 4 がインバータとして動作するアクティブ状態となる。 【0043】その他のドライブTFTM1~M3、選択 スイッチであるトランジスタM4~M9等は図1と同じ 40 ものである。図3の回路の動作を説明する。

【0044】(1)今、Y軸のシフトレジスタの選択信 号ymが『H』の時、まず、選択信号Xn1が『H』と なると、トランジスタM4とトランジスタMでポオンと なる。このため、この時のデジタルの画像データ信号V Lがインバータ 5 を介してドライブTFTM 1 のゲート に与えられる。この時のゲート電圧は、トランジスタM 7がオフとなった時、クロックドインバータ2とインバ ータ5のラッチ回路により保持される。

【0045】(2)次に、選択信号Xn2が「H」とな 【0037】(2)次に、選択信号X n2m「H」にな 50 ると、トランジスタM5 とトランジスタM8mオンとな

(5)

る。このため、この時のデジタル画像データVLがイン バータ6を介してドライブTFTM2のゲートに与えら れる。この時のゲート電圧は、トランジスタM8がオフ となった時に、クコックドインバータ3とインバータ6 のラッチ回路により保持される。

【0046】(3) 次に、選択信号Xn3が H.となると、トランジスタM6とトランジスタM9がオンとなる。このため、この時のデジタル画像データVLがインバータ7を介してドライブTFTM3のゲートに与えられる。この時のゲート電圧は、トランジスタM9がオフ 10となった時に、クコックドインバータ4とインバータ7のラッチ回路により保持される。

【0047】このように、1画素中のgmの異なるドライブTFTM1~M3の組み合わせによって、EL素子に流れる電流を制御し、ラッチ回路により選択スイッチのオブ電流やドライブTFTのゲート、リーク電流の影響等を受けなくすることができる。

【0048】なお、前記実施例では、1 画素中にドライブTFTを3個設けた場合の説明をしたが、これに限らず2個又は4個以上とすることもできる。また、ラッチ 20回路として、フリップフコップ等の他の回路を用いることもできる。更に、ドライブTFT又は選択スイッチであるトランジスタは、異なるチャネルのものを使用することもできる。

[0049]

【発明の効果】以上のように本発明によれば次のような 効果がある。

(1)請求項1記載の発明によれば、1画素中の複数の

ドライブTFTのオン、オフの組み合わせを選択することによって、EL素子に流れる電流を制御して落調表示を行っており、このドライブTFTの駆動電圧は、オン、オフのデジタル信号なので選択スイッチ等のフィズの影響を受けにくくなる。

【0050】(2)請求項2記載の発明によれば、1 画素中にgmの異なる複数のドライブTFTを設けたので、高階調の表示を行うことができる。

(3)請求項3記載の発明によれば、ドライブTFTの 駆動信号をラッチ回路により保持したので、選択スイッ チのオブ電流、ドライブTFTのゲート、リーク電流等 の影響を受けなくすることができる。

#### 【図面の簡単な説明】

- 【図1】本発明の第1実施例の説明図である。
- 【図2】第1実施例における波形説明図である。
- 【図3】第2実施例の説明図である。
- 【図4】 従来例の説明図である。
- 【図5】従来例のX軸シフトレジスタの説明図である。
- 【図6】従来例の波形説明図である。

#### 【符号の説明】

1 EL電源

C1~C3 コンデンサ

ELnm EL素子

M1~M3 FFTTTTT

M4~M9 トランジスタ (選択スイッチ)

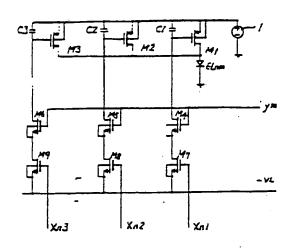
y m 選択信号

Xn1~Xn3 選択信号

-VL 画像データ信号

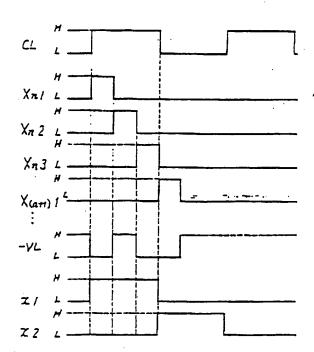
[図1]

# 本発明の第1実施例の説明図

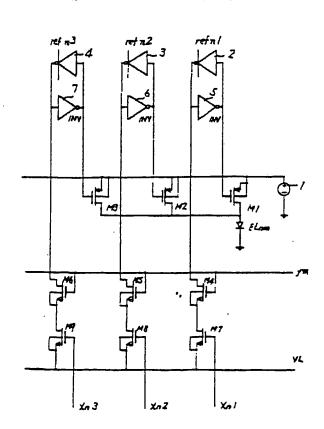


[図2]

## 第1 実施例における液形説明 図



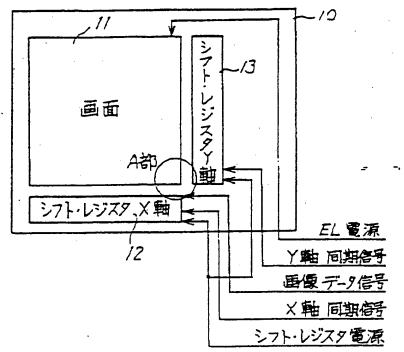
[図3] 第2 実施例の説明図



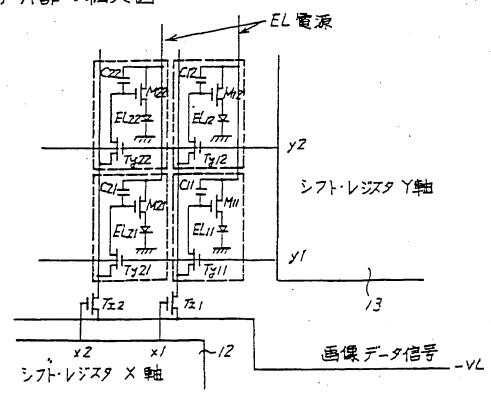
[図4]

# 従来例の 説明図

# (a) パネルブロック図



# (b) A部の拡大図



[図5]

従来例のX軸シフトレジスタの 説明図

